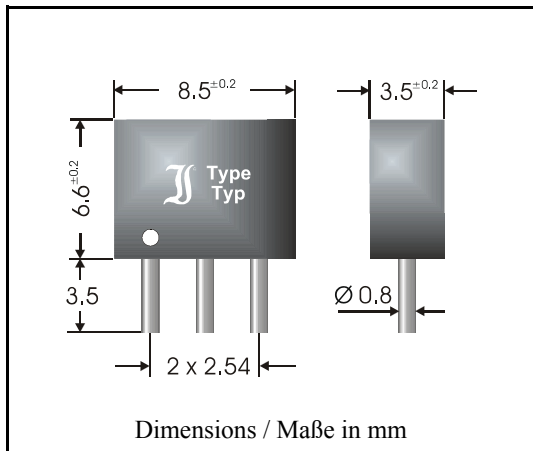
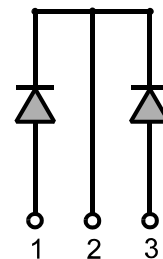
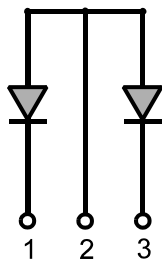


Silicon-Twin Diodes
Center tap

Silizium-Doppeldioden
Mittelpunktschaltung



Nominal power dissipation	1.2 W
Nenn-Verlustleistung	
Repetitive peak reverse voltage	150 V
Periodische Spitzensperrspannung	
3 Pin-Plastic case	8.5 x 3.5 x 6.6 [mm]
3 Pin-Kunststoffgehäuse	
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk	see page 22
Standard Lieferform: lose im Karton	s. Seite 22



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden

"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DAN 208	100	150
DAP 208	100	150

Max. average forward rectified current, R-load, for one diode operation only for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV}	1.0 A ¹⁾
		I_{FAV}	2.0 A ¹⁾
Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last, für eine einzelne Diode bei gleichzeitigem Betrieb	$T_U = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV}	1.0 A ¹⁾
		I_{FAV}	2.0 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	10 A

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	- 50...+150°C

Characteristics			Kennwerte
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	$V_F < 1.2\text{ V}^1)$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 100\text{ V}$	$I_R < 10\ \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{thA} < 45\text{ K/W}^2)$

¹⁾ Valid for one diode – Gültig für eine Diode

²⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten